(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-351280

(43)公開日 平成4年(1992)12月7日

(51) Int.Cl.5	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
B 2 3 K 26/00	Н	7920 - 4 E		
26/06	E	7920 – 4 E		
G 0 2 B 9/58	•	$8106 - 2 \mathrm{K}$		
26/02	В	7820 – 2 K		
•		7352 - 4M	H 0 1 L 21/30 3 2 1	
		•	審査請求 未請求 請求項の数4(全 4	頁) 最終頁に続く
(21)出願番号 特願平2-414117			(71)出願人 592062622 株式会社エムアイデイ・	
(22)出願日	平成2年(1990)12月26日		神奈川県川崎市多摩区登戸369	

(71)出願人 592096753 ジエーヴイエフ インク JVF INCORPORATED イギリス領 ケイマン諸島 グランドケイ

マン ジヨージタウン ウエストウインド ビルデイング ピー、オー、ポツクス

1040

(74)代理人 弁理士 高月 猛

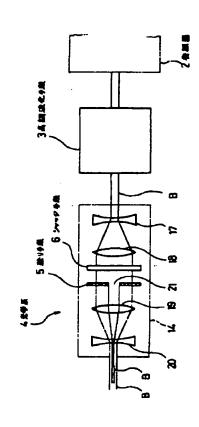
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 薄膜精密加工用のYAGレーザ加工機

(57)【要約】

【目的】例えば、プリント基板製造工程や半導体製造工 程で用いるフォトマスクにパターンを描画するのに要求 されるような精度の薄膜加工が可能なYAGレーザ加工 機の提供を目的としている。

【構成】レーザビームBの外側部を遮断してそのビーム 径を細くするための絞り手段5を設け、また発振器2の 外にレーザピーム照射のON・OFF制御を行うための シャッタ手段6を設け、またレーザピームを高調波にす るための高調波化手段3を設けるようにしている。



【特許請求の範囲】

発振器から発振されたレーザピームを、 【請求項1】 複数のレンズからなる光学系で導き、光学系の先端にあ る集光レンズによりスポット状に集光させて被加工物に 照射するようにしてなるYAGレーザ加工機に於いて、 光学系を形成するレンズの間に、レーザピームの外周部 分を遮断してそのピーム径を細くするための絞り手段を 設けたことを特徴とする薄膜精密加工用のYAGレーザ 加工機。

【請求項2】 Qスイッチが設けられており、このQス イッチによりQスイッチ発振を行うようにした発振器を 備えるYAGレーザ加工機に於いて、被加工物へのレー ザピーム照射のON・OFF制御を行うシャッタ手段を 発振器の外に設けたことを特徴とする薄膜精密加工用の YAGレーザ加工機。

【請求項3】 発振器から発振されたレーザピームを高 調波にする高調波化手段を設けた薄膜精密加工用のYA Gレーザ加工機。

【請求項4】 Qスイッチ発振の発振器から発振された レーザピームを、複数のレンズからなる光学系で導き、 光学系の先端にある集光レンズによりスポット状に集光 させて被加工物に照射するようにしてなるYAGレーザ 加工機に於いて、光学系を形成するレンズの間に、レー ザビームの外周部分を遮断してそのビーム径を細くする ための絞り手段を設けると共に、発振器の外に、レーザ ピーム照射のON・OFF制御を行うシャッタ手段を設 け、さらに、レーザピームを高調波にする高調波化手段 を設けたことを特徴とする薄膜精密加工用のYAGレー ザ加工機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、YAGレーザ加工機 に関し、殊に、例えばプリント基板製造工程や半導体製 造工程で微細なパターンを直接的に描画するような加工 に好適な薄膜精密加工用のYAGレーザ加工機に関す

[0002]

【従来の技術】YAGレーザは、発振波長が1.06μmと いう比較的短波長であり、また高平均出力を得易く、し かも装置が比較的コンパクトである等の特徴を有してお 40 り、小物加工や微細加工の分野に多く用いられている。 しかし、微細加工と言っても従来可能であった微細加工 は、例えば、半導体の製造分野に例をとると、ICパッ ケージのマーキング加工や、リペア、つまりICの製造 工程で用いられるフォトマスクの欠陥修正加工のような もので、必ずしもその能力や特性を十分に活かした利用 とは言えないものであった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】そこで、当発明者は、 YAGレーザの特性を十分に活かしてより高精度な微細

加工を可能とし、例えば高実装密度のプリント基板の製 造工程や半導体製造工程で用いるフォトマスクにパター ンを直接的に描画するようなより加工価値の高い加工を 可能とするYAGレーザ加工機の開発を進めて来た。こ のような高精度な微細加工の実現においてもっとも問題 になるのは、如何に効率よくピーム径を細くして被加工 物に照射されるピームスポットの径を小さくし且つ精密 にするかであり、また、得られた細いビームを如何に安 定した条件、つまり装置の振動や加工速度の変化による 加工のパラツキや、発振器の発振状態のパラツキ等が少 なくて常に一定した条件で加工できるようにするかであ る。すなわち、この発明は、前記の如き諸課題を解決す ることによりなされたもので、薄膜精密加工用のYAG レーザ加工機の提供を目的としている。

[0004]

20

【課題を解決するための手段】この発明による薄膜精密 加工用のYAGレーザ加工機は、発振器から発振された レーザビームを、複数のレンズからなる光学系で導き、 光学系の先端にある集光レンズによりスポット状に集光 させて被加工物に照射するようにしてなり、しかも、光 学系を形成するレンズの間に、レーザビームの外周部分 を遮断してそのピーム径を細くするための絞り手段が設 けられている。これによれば、絞り手段でレーザビーム の外周部分を遮断することによりピーム径が細くされて いるが、これは、レーザピームの外周部分がエネルギ分 布からみてこの部分を捨てても薄膜加工の場合には実用 上余り加工エネルギ効率に影響しないという知見に基づ くものである。また、このようにしてビーム径を細くす ることにより、レーザピームの外周部分に含まれるラン 30 ダムなピークを持つ不良成分を除去でき、ピームスポッ トをより精密なものにできる。さらに、絞り手段を光学 系のレンズの間に設けるようにしているが、このような 構成とすることにより、レーザピームによる絞り手段の 損傷を避けることができる。すなわち、光学系のレンズ の間で拡大されたレーザピームは拡大率に応じてそのエ ネルギ密度が低下するので拡大状態のレーザピームであ れば絞り手段が損傷を受けずに済むということである。

【0005】また、この発明による薄膜精密加工用のY AGレーザ加工機は、QスイッチによりQスイッチ発振 を行うようにした発振器を備える一方で、被加工物への レーザビーム照射のON・OFF制御を行うためのシャ ッタ手段が発振器の外に設けたられている。 したがっ て、レーザピーム照射のON・OFF制御は発振器外の シャッタ手段にて行うことができ、加工作業中に発振器 の停止・起動を行わなくとも済む。これにより、精密加 工をより安定的に行えるようになる。すなわち、Qスイ ッチ発振は一般に連続的に発振させている時には安定的 な発振が得られるが、使い始めの起動や途中で発振を止 めた後の起動の初期に出力が不安定化するという性質を **- 50 特っており、この僅かな出力の不安定化でも薄膜の精密**

加工には少なからざる影響を及ぼすが、本加工機によれば加工中に発振器の停止・起動を行わずに済み、起動初期の出力不安定化の影響を避けることができる。

【0006】また、この発明による薄膜精密加工用のYAGレーザ加工機は、発振器から発振されたレーザピームを高調波にする高調波化手段が設けられている。このようにレーザピームを高調波化して用いることにより、ピームスポット径のより一層の微細化が実現でき、この高調波によるピームスポット径の微細化は、薄膜の加工について1.06μmの基本波長の場合に比べ飛躍的な変化をもたらす。すなわち、径を機械的に小さくできることは当然として、高調波化により得られるエネルギの高密度化が薄膜の加工に対し思いがけない適性を持っており、基本波長の場合では生じ易いドロスの発生を全く見ないような精密な加工が可能となる。

[0007]

【実施例】以下、この発明の実施例を説明する。この実施例によるYAGレーザ加工機 1 は、図 2 に示すように、発振器 2、高調波化手段 3、及び光学系 4 を備えると共に、図 1 に示すように、光学系 4 内に絞り手段 5、及びシャッタ手段 6 を備えている。発振器 2 は、YAGロッド 1 0、前後一対の反射ミラー 1 1、1 1、Qスイッチ 1 2、及びアパーチャ 1 3 を備え、Qスイッチ 1 2の操作によりQスイッチ発振を行えるようになっており、また、発振されるレーザピームBのピーム径がアパーチャ 1 3 により一定の径となるようになっている。ここで、一定の径とは、発振器 2 から発振可能な範囲で出来るだけ絞った径のことで、この例では1.3 mmとなるようにされている。

【0008】高調波化手段3は、発振器2から波長1.06 μmで発振されたレーザピームBを高調波化するための もので、この例では第2高調波(波長532nm)が得 られるものを用いている。光学系4は、発振器2からの レーザピームBの平行性をより高めるための平行化用光 学系14、及び平行化用光学系14から出たレーザビー ムBをスポット状に集光させて被加工物Mに照射するた めの集光レンズ15、それに平行化用光学系14と集光 レンズ15との間で光路を90°変化させるために設け られた反射ミラー16により形成されている。平行化用 光学系14は、図1に示すように、入射側から順に拡大 用凹レンズ17、平行化用凸レンズ18、縮小用凸レン ズ19、及び平行化用凹レンズ20を配列してなってい る。そして、ここを通るレーザピームBは、拡大用凹レ ンズ17で所定倍率、この例では5倍に拡大された状態 で平行化用凸レンズ18で平行化され、それから縮小用 凸レンズ19で1/5に縮小された後、平行化用凹レン ズ20で平行化されることにより、より高い平行度が得 られるようになっている。

【0009】絞り手段5は、1.3 mmの径で発振器2から発振されたレーザピームBの径をより細くして集光レ 50

ンズ15によるスポットのスポット径をより小さくする ためのもので、必要な縮細度に応じた例えば1mmの径 の通孔21を有する板状体として形成され、通孔21の 中心が光路の中心に来るようにして平行化用凸レンズ1 8と縮小用凸レンズ19との間に配されており、通孔2 1以外の部分についてレーザピームBを遮断できるよう になっている。尚、この絞り手段5は、通孔21の径の 異なるものと交換することにより縮細度を変えることが できるようになっている。したがって、絞り手段5が介 在させられた平行化用光学系14を通過するレーザピー ムBは、平行化用凸レンズ18と縮小用凸レンズ19と の間で絞り手段5によりその径が機械的に絞られると共 に、外周部分における不良成分が除去され、この不良成 分が除去されてより精密化された例えば1mm径の状態 で縮小用凸レンズ19に入り、最終的には0.2 mm径と なって集光レンズ15に入ることになる。この結果、従 来のものに較べ格段に細くなった約2~5μmというス ポット径が得られ、例えば、4メガピットクラスの半導 体の製造で用いるフォトマスクにパターンを直接的に描 画するような加工、さらには半導体の基材にパターンを 直接的に描画するような加工も可能となっている。尚、 図中に絞り手段5を用いなかった場合のレーザビームB の状態を2点鎖線で示してある。

【0010】シャッタ手段6は、絞り手段5と同じく、平行化用凸レンズ18と縮小用凸レンズ19との間に配されている。このシャッタ手段6は、レーザビームBの被加工物Mへの照射のON・OFF制御を行うためのもので、このように発振器2の外に設けシャッタ手段6でレーザビーム照射のON・OFF制御を行うことにより、精密加工をより安定的に行えるようになる。すなわち、このようなシャッタ手段6を用いることにより、加工中に発振器の停止・起動を行わずに済み、起動初期の出力不安定化の影響を避けることができる。尚、シャッタ手段6の細かな構造については、従来より知られているものを適宜に利用できるので、その説明を省略している。

【0011】ここで、絞り手段5及びシャッタ手段6を平行化用凸レンズ18と縮小用凸レンズ19との間に配したのは、レーザピームBによる絞り手段5及びシャッタ手段6の損傷を避けるためである。すなわち、平行化用凸レンズ18と縮小用凸レンズ19との間では前述のようにレーザピームBが5倍に拡大されており、そのエネルギが1/5となっているので、ここに設ければ、絞り手段5及びシャッタ手段6を損傷させずに済む。

[0012]

【発明の効果】この発明によるYAGレーザ加工機は、以上説明してきた如く、絞り手段によりレーザビームの外周部分を遮断することによりビーム径を細くし且つより精密なものとし、あるいは、レーザビーム照射のON・OFF制御は発振器の外に設けシャッタ手段にて行う

5

ことによりレーザビーム出力を安定化させ、あるいは、 高調波化手段を設けてレーザビームを高調波化させるよ うにしているので、従来のYAGレーザ加工機に較べ格 段に精密な加工を高精度で行える。

【図面の簡単な説明】

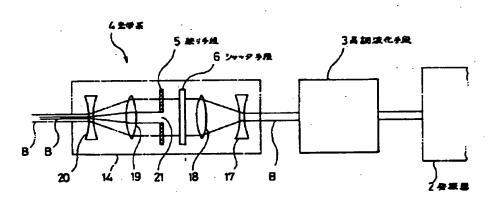
【図1】平行化用光学系と絞り手段及びシャッタ手段と の関係を示す概略構成図である。

【図2】この発明によるYAGレーザ加工機の概略構成図である。

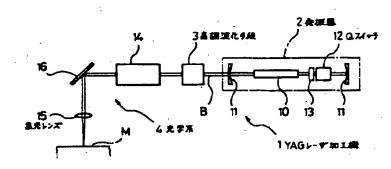
【符号の説明】

- 1 YAGレーザ加工機
- 2 発振器
- 3 高調波化手段
- 4 光学系
- 5 絞り手段
- 6 シャッタ手段
- 12 Qスイッチ
- 15 集光レンズ.

【図1】



[図2]



7630 - 4M

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H 0 1 L 21/027	-			
H O 1 S 3/100		7630 - 4M		

(72) 発明者 石山 里丘

3/11

神奈川県川崎市高津区坂戸100番地 1 株式会社マテリアルアンドインテリジエント デバイス研究所内